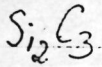


$Si_2 C_3$



1958



Drowart J., De Maria G.,
Inghram M. G.

J. Chem. Phys 1958 29 N5, 1015

от*

2000-2300°K

Исследование SiC
с использованием масс-спек-
трометра.

Si_2C_3 рассматривается как аналог

CO_2 , $p=1$,

$w_1=1320$, $w_2=360$, $w_3(2)=968$

$w_4=155(2)$, $w_5=2000$, $w_6=537$, $w_7=560(2)$

Оттиск (83)

(см. SiC) I

Tok

q^{*}

2000

86,94

2100

88,02

2200

89,06

2300

90,07